

Market News

OptiMOS™ Linear FET kombiniert niedrigen $R_{DS(on)}$ mit großem sicheren Arbeitsbereich

München, 25. Juli 2017 – Die Infineon Technologies AG legt die OptiMOS™-Linear-FET-Serie auf. Die neue Produktfamilie kombiniert den bestmöglichen Durchlasswiderstand ($R_{DS(on)}$) eines Trench-MOSFETs mit dem breiten sicheren Arbeitsbereich (Safe Operating Area, SOA) eines planaren MOSFETs. Dies beseitigt den bisherigen Widerspruch zwischen niedrigem $R_{DS(on)}$ und der Fähigkeit zum Linearmodus. Der OptiMOS Linear FET arbeitet im Sättigungsbereich eines MOSFETs vom Anreicherungstyp. Er ist ideal geeignet für Hot-Swap-, E-Sicherungs- und Schutzanwendungen, die häufig in [Telekom-](#) und [Batteriemanagementsystemen](#) (BMS) zu finden sind.

Sowohl der robuste Betrieb im Linearmodus als auch der höhere Impulsstrom sorgen für niedrige Leitungsverluste, schnelleres Anspringen und kürzere Ausfallzeit. Der OptiMOS Linear FET begrenzt hohe Einschaltströme und verhindert damit Schäden unter Last bei einem Kurzschluss.

Verfügbarkeit

Der OptiMOS Linear FET ist ab sofort in drei Spannungsklassen erhältlich: 100 V, 150 V und 200 V. Die Varianten sind lieferbar in den Gehäusetypen D²PAK oder D²PAK-7Pin. Diese entsprechen dem Industriestandard und bieten mit der kompatiblen Abmessung die Möglichkeit für einfachen Ersatz. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/optimos-linearfet.